

Attorney's Docket No.: 16283-002001 / P1P2002382US

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Kazuo Tanaka et al.

Art Unit : Unknown

Serial No.: 10/627,944

Examiner: Unknown

Filed : J

: July 25, 2003

Title

: OPTICAL WAVEGUIDE DEVICE

Commissioner for Patents

P.O. Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENTS UNDER 35 USC § 119

Applicants hereby confirm their claim of priority under 35 USC § 119 from Japan Application No. 2002-217084 filed July 25, 2002 and Japan Application No. 2003-018997 filed January 28, 2003. Certified copies of each application from which priority is claimed is submitted herewith.

Please apply any charges or credits to Deposit Account No. 06-1050.

Respectfully submitted,

Date: 8-12-03

Y Rocky Tsao

Reg. No. 34,053

Fish & Richardson P.C. 225 Franklin Street Boston, MA 02110-2804

Telephone: (617) 542-5070 Facsimile: (617) 542-8906

20707629.doc

CERTIFICATE OF MAILING BY FIRST CLASS MAIL

I hereby certify under 37 CFR §1.8(a) that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail with sufficient postage on the date indicated below and is addressed to the Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450

Diane -

Typed or Printed Name of Person Signing Certificate

日本 国 特 許 庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 7月25日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-217084

[ST.10/C]:

[JP2002-217084]

出 願 人
Applicant(s):

岐阜大学長

2003年 6月23日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



特2002-217084

【書類名】 特許願

【整理番号】 PY20021139

【提出日】 平成14年 7月25日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G02B 6/10

【発明者】

【住所又は居所】 岐阜県岐阜市石原880番地68

【氏名】 田中 嘉津夫

【発明者】

【住所又は居所】 岐阜県岐阜市則武中1丁目10番11号

【氏名】 田中 雅宏

【特許出願人】

【識別番号】 391012257

【氏名又は名称】 岐阜大学長

【代理人】

【識別番号】 100068755

【弁理士】

【氏名又は名称】 恩田 博宣

【選任した代理人】

【識別番号】 100105957

【弁理士】

【氏名又は名称】 恩田 誠

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光導波装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の光を伝搬可能な光導波路を有する光導波装置において、前記光導波路は、その光伝搬方向に沿う少なくとも一部での前記光伝搬方向に交差する断面の形状が、当該光導波路を介して伝搬される光の偏光方向を幅方向とした場合に、当該幅方向における内面幅寸法が前記伝搬される光の波長の1/2よりも小さな値の幅狭部を有する形状とされ、且つ、その内面全体のうち少なくとも前記幅狭部の幅方向で対向する内面部分がプラズモン活性媒質により構成されたことを特徴とする光導波装置。

【請求項2】 所定の光を伝搬可能な光導波路を有する光導波装置において、前記光導波路は、その光伝搬方向に沿う少なくとも一部での前記光伝搬方向に交差する断面の形状が、当該光導波路を介して伝搬される光の偏光方向を幅方向とした場合に、当該幅方向における内面幅寸法が前記伝搬される光の波長の1/2よりも小さな値の幅狭部と当該幅狭部よりも前記内面幅寸法が大きな値の幅広部とが前記幅方向と交差する方向に連続して繋がった形状とされ、且つ、その内面全体のうち少なくとも前記幅狭部の幅方向で対向する内面部分がプラズモン活性媒質により構成されたことを特徴とする光導波装置。

【請求項3】 前記光導波路は、前記幅狭部を有する部分での前記断面の形状において、前記幅方向と直交する方向での当該光導波路の形状寸法が、前記幅狭部で発生する表面プラズモンの位相速度を前記伝搬される光の真空中の速度で除した値に、当該伝搬される光の波長の1/2を乗じて得られる値よりも大きな値に設定されている請求項1又は請求項2に記載の光導波装置。

【請求項4】 前記プラズモン活性媒質は、比誘電率の実数部が負の値の誘電体媒質である請求項1~3のうち何れか一項に記載の光導波装置。

【請求項5】 前記光導波路は、前記幅狭部を複数有しており、当該幅狭部を有する部分での前記断面の形状は、各幅狭部と幅広部が前記幅方向と交差する方向へ交互に連続して繋がった形状とされている請求項2~請求項4のうち何れか一項に記載の光導波装置。

【請求項6】 前記光導波路は、前記伝搬される光を導出可能に形成された端部開口の開口形状が前記幅狭部を有する形状とされている請求項1~請求項5のうち何れか一項に記載の光導波装置。

【請求項7】 前記光導波路は、当該光導波路の全体に亘り、光伝搬方向に交差する断面の形状が、前記端部開口の開口形状と同一となるように形成されている請求項6に記載の光導波装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、例えば走査近接場光学顕微鏡や光情報記録装置等において使用された場合に好適な光導波装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

近年、光の波長(可視光: 0.4~0.8ミクロン)よりも微小な領域における光学的処理を可能にする技術として、近接場光(光の波長よりも短い距離の領域にのみ届く光)を利用した技術が注目を浴びている。例えば、走査近接場光学顕微鏡の分野では、先端に光の波長よりも小さな微小開口が形成された光ファイバ等からなる光プローブが光導波装置として用いられている。そして、試料表面の微小な領域を観察する際には、前記光プローブの微小開口が観察対象たる前記微小な領域に近接配置され、微小開口の表面近傍に滲み出す光の場(近接場)を試料表面に接触させるようにしている。そして、この近接場と結合した試料表面の前記微小な領域のみが前記近接場光にて照射されるようにし、その照射による試料からの反射光、散乱光、又は透過光を検出して前記微小な領域を局所的に観察評価するようにしている。従って、このような光導波装置の一種である光プローブに関しては、例えばCD等の光記録媒体における記録ビットの微小化要請や、サブミクロンの微細加工を行う半導体製造プロセスの評価などに寄与するため、従来から、種々の光プローブが光導波装置として提案されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、近接場光の光強度は、光プローブにおける先端開口の大きさが光の 波長よりも小さな微小開口であるため、例えばイルミネーションモードの場合に は、その微小開口から滲み出す近接場光の光強度は、光プローブに導入された光 強度の約1/1000程度という非常に微弱なものとなってしまう。従って、例えば光情報記録装置等における高速書き込みや読み出しには、光量不足となって 支障を来すことになるため、実用面では前記微小開口から滲み出す近接場光の光 強度を増強させる必要がある。しかし、近接場光の光強度を増強するために、光源を強くした場合にはコストの増大につながる一方、先端開口を大きくした場合には光の広がりが増大して解像度を低下させることになってしまうため、いずれ の場合も実用面での支障を良好に回避できるものではなかった。

[0004]

本発明は、このような事情に鑑みなされたものであり、その目的は、光導波路を介して伝搬される光の光強度を、その光の広がりの増大を招くことなく、低コストで増強することができる光導波装置を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するために、本願請求項1に記載の発明は、所定の光を伝搬可能な光導波路を有する光導波装置において、前記光導波路は、その光伝搬方向に沿う少なくとも一部での前記光伝搬方向に交差する断面の形状が、当該光導波路を介して伝搬される光の偏光方向を幅方向とした場合に、当該幅方向における内面幅寸法が前記伝搬される光の波長の1/2よりも小さな値の幅狭部を有する形状とされ、且つ、その内面全体のうち少なくとも前記幅狭部の幅方向で対向する内面部分がプラズモン活性媒質により構成されたことを要旨とした。

[0006]

また、本願請求項2に記載の発明は、所定の光を伝搬可能な光導波路を有する 光導波装置において、前記光導波路は、その光伝搬方向に沿う少なくとも一部で の前記光伝搬方向に交差する断面の形状が、当該光導波路を介して伝搬される光 の偏光方向を幅方向とした場合に、当該幅方向における内面幅寸法が前記伝搬さ れる光の波長の1/2よりも小さな値の幅狭部と当該幅狭部よりも前記内面幅寸 法が大きな値の幅広部とが前記幅方向と交差する方向に連続して繋がった形状とされ、且つ、その内面全体のうち少なくとも前記幅狭部の幅方向で対向する内面部分がプラズモン活性媒質により構成されたことを要旨とした。

[0007]

また、本願請求項3に記載の発明は、前記請求項1又は請求項2に記載の発明において、前記光導波路は、前記幅狭部を有する部分での前記断面の形状において、前記幅方向と直交する方向での当該光導波路の形状寸法が、前記幅狭部で発生する表面プラズモンの位相速度を前記伝搬される光の真空中の速度で除した値に、当該伝搬される光の波長の1/2を乗じて得られる値よりも大きな値に設定されていることを要旨とした。

[0008]

また、本願請求項4に記載の発明は、前記請求項1~請求項3のうち何れか一項に記載の発明において、前記プラズモン活性媒質は、比誘電率の実数部が負の値の誘電体媒質であることを要旨とした。

[0009]

また、本願請求項5に記載の発明は、前記請求項2~請求項4のうち何れか一項に記載の発明において、前記光導波路は、前記幅狭部を複数有しており、当該幅狭部を有する部分での前記断面形状は、各幅狭部と幅広部が前記幅方向と交差する方向へ交互に連続して繋がった形状とされていることを要旨とした。

[0010]

また、本願請求項6に記載の発明は、前記請求項1~請求項5のうち何れか一項に記載の発明において、前記光導波路は、前記伝搬される光を導出可能に形成された端部開口の開口形状が前記幅狭部を有する形状とされていることを要旨とした。

[0011]

また、本願請求項7に記載の発明は、前記請求項6に記載の発明において、前 記光導波路は、当該光導波路の全体に亘り光伝搬方向に交差する断面の形状が、 前記端部開口の開口形状と同一となるように形成されていることを要旨とした。

[0012]

【発明の実施の形態】

以下、本発明を具体化した一実施形態を図1~図8に従って説明する。

図1に示すように、本実施形態に係る光導波装置11は、矩形板状をなす金属製板体12を装置本体として備えている。この金属製板体12は比誘電率の実数部が負の値となる誘電体媒質、即ち、負誘電体媒質(プラズモン活性媒質)により構成されている。なお、本実施形態では、伝搬される光の波長が488nmである場合を例示するものとし(以下において同じ)、その一例として、かかる場合に前記実数部の値がマイナス7.38になる銀(Ag)にて前記金属製板体12を構成している。ちなみに、誘電体媒質における比誘電率とは、真空中の誘電率に対する当該誘電体媒質の誘電率の比として表される。

[0013]

また、図1及び図3(a)(b)に示すように、前記金属製板体12には、その厚さ方向へ、光を伝搬するための光導波路13が貫通形成されており、その基端側開口となる裏面側開口14には、図示しない光源に接続された光ファイバドが光源からの光を光導波路13内へ入射可能に接続されている。なお、この光ファイバドは、高屈折率媒質をコアとし、低屈折率媒質をクラッドとする光閉じ込め型の導波路構造を有する公知のものであり、そのコア先端が前記光導波路13の裏面側開口14に光伝搬可能に接続されたものである。また、前記金属製板体12の厚さに関しては、少なくとも光導波路13内を伝搬される光の波長の1/4程度以上あることが当該光導波路13の内表面に表面プラズモンを発生させる上では好ましい。

[0014]

一方、前記金属製板体12の表面部12aには、その大きさが光の波長よりも小さな微小開口15が前記光導波路13の先端側開口(端部開口)として形成されている。そして、この微小開口15は、光導波路13を介して伝搬される光の伝搬方向(図1及び図2において乙方向)に直交する断面の形状(微小開口15では、その開口形状)が以下に説明するような特徴的な形状とされている。

[0015]

即ち、この微小開口15は、図1及び図2に示すように、前記表面部12aの

ほぼ中央に位置する幅狭部16と当該幅狭部16よりも内面幅寸法の大きい2つの幅広部17とが交互に連続した開口形状に形成されている。そして、当該微小開口15において、前記幅狭部16と幅広部17は、前記光導波路13を介して伝搬される光の偏光方向(図1及び図2においてX方向)を幅方向とした場合、その幅方向と直交する方向(図1及び図2においてY方向)へ、交互に連続して繋がった形状となるように構成されている。なお、前記微小開口15の大きさは金属製板体12(及びその表面部12a)の大きさとの対比において実際には極小さなものであるが、図1等においては微小開口15の特徴的な開口形状を容易に理解ならしめるため、その大きさが実際よりは誇張して図示されている。

[0016]

また、前記微小開口15は、前記幅狭部16の内面幅寸法ax(図2参照)が 伝搬される光の波長(本実施形態では、488nm)よりも小さな値に設定され るものであり、本実施形態では、当該光の波長の1/2よりも小さな値(一例と して、31nm)に、前記内面幅寸法axを設定している。前記内面幅寸法ax に関して、このような条件を設定する理由は、光導波路13の内表面(特に、幅 狭部16において幅方向で対向する内面部分18)に表面プラズモンという光波 (電磁波)が発生したときに、その電界を強くすると共に、その位相速度を遅く させて幅狭部16に光が集束するようにするためである。なお、表面プラズモン に関しては、一般に、表面プラズモンポラリトンとも呼ばれるが、本明細書中で は、表面プラズモンと記載することにする。

[0017]

また、前記微小開口15は、前記幅狭部16と幅広部17が連続する方向(図1,図2のY方向)における当該微小開口15の形状寸法L(図2参照)が一例として217nmに設定されている。なお、この形状寸法Lに関しては、前記幅狭部16で発生する表面プラズモンの位相速度を前記伝搬光の真空中の速度で除した値に前記伝搬光の波長の1/2を乗じて得られる値(以下、「形状寸法計算値」という。)よりも大きな値に設定されるものである。前記形状寸法Lに関して、このような条件を設定する理由は、前記幅狭部16の内面幅寸法a×を伝搬光の波長の1/2よりも小さな値に設定した場合において前記形状寸法Lが前記

形状寸法計算値よりも小さいと、当該伝搬光が前記微小開口15を通過できなくなることがあるからである。なお、前記微小開口15におけるその他の内表面部位の各寸法(図2参照)に関しては、伝搬光の波長との関係において、特段の条件は設定されていない。ちなみに、本実施形態では、一例として、幅狭部16の内面長さ寸法ayを前記内面幅寸法axと同寸法の31nmに、各幅広部17の内面幅寸法bxを78nmに、各幅広部17の内面長さ寸法byを93nmに設定している。

[0018]

また、本実施形態において、前記光導波路13は、図3(a)(b)からも理解されるように、当該光導波路13の全体に亘り光伝搬方向に直交する断面の形状が前記微小開口15の開口形状と同一となるように形成されている。従って、前記光導波路13は、幅狭部16における前記内面部分18を含む光導波路13の内面全体が銀(Ag)にて構成されると共に、その内面全体に亘り前記幅狭部16が前記微小開口15から裏面側開口14まで連続形成されていることになる

[0019]

次に、本実施形態に係る光導波装置11の作用について説明する。なお、以下の説明では、光導波装置11の光導波路13内に裏面側開口14から所定の光を入射して、先端側開口である微小開口15からスポット光を滲み出させる場合、即ち、イルミネーションモードの場合を例にして説明するものとする。また、光導波路13内に入射される所定の光については、前述したように波長が488nmで、偏光方向が図1及び図2でX方向となる直線偏光の平面波とした場合を例にして説明するものとする。

[0020]

さて、光ファイバFを介して前記所定の光が金属製板体12の光導波路13内に入射されると、当該光導波路13内では次のような現象が発生する。即ち、光導波路13が貫通形成された金属製板体12は、光の波長が488nmの場合に比誘電率の実数部の値がマイナス7.38の銀(Ag)により構成されていた。つまり、負誘電体媒質により構成されていた。そのため、この金属製板体12は

、光波領域において、導体というよりはプラズモン活性媒質として振る舞うことになる。従って、光導波路13の内表面では、表面電荷の誘起に伴い電荷の振動が起き、伝搬方向が当該内表面に沿う方向(図2の乙方向)の表面プラズモンという光波(電磁波)が発生する。

[0021]

この表面プラズモンは、前記光導波路13の内表面と当該光導波路13内に満ちている空気(誘電体)との界面S(図4参照)に垂直な方向には伝搬しない表面波である。そのため、この表面プラズモンが発生すると、光導波路13内では、主に前記界面Sに平行な(即ち、幅狭部16では図1及び図2で主にY方向成分をもつ)磁界が発生する一方、この磁界と直交するように、主に前記界面Sに垂直な(即ち、幅狭部16では図1及び図2で主にX方向成分をもつ)電界が発生する。

[0022]

ここで、一般に、負誘電体媒質における表面プラズモンの電界強度は、その表面(即ち、界面S)から離れるにつれて指数関数的に減衰するということが知られている。しかし、本実施形態の場合は、光導波路13の内表面のうち、幅狭部16では、幅方向で対向する内面部分18の内面幅寸法axが31nmという微小な間隔に設定されている。そのため、図4に示すように、幅狭部16では互いに対向する両界面Sにおいて各々発生した表面プラズモンの電界同士が結合することになる。従って、光導波路13内において表面プラズモンの電界強度は幅狭部16の部分で非常に強くなる。なお、図4において符号eは電界の強度分布を示すものである。

[0023]

また、例えば走査近接場光学顕微鏡における解像力を高めるため、あるいは、 光情報記録装置において記録密度を上げるためには、光導波路13の先端側開口 である微小開口15から出る光の広がり分布の大きさを小さくすることが必要で ある。そこで、前記表面プラズモンの図1及び図2における乙方向への位相速度 の大きさを光導波路13における前記幅狭部16の内面幅寸法axの大きさとの 関係において検討してみると、図5に示すような結果が得られた。

[0024]

即ち、図5において、横軸は、光導波路13(及び微小開口15)における幅狭部16の内面幅寸法axの大きさを表しており、その目盛り数値はナノメータ(nm)単位である。また、縦軸は、前記幅狭部16を通過する表面プラズモンの位相速度vzの光速Cに対する速度比率(vz/C)を表しており、その目盛り数値は、伝搬光の真空中の速度(光速C)を「1」とした場合における速度比率(vz/C)の値を示している。従って、縦軸における速度比率(vz/C)の目盛り数値が小さくなればなるほど、表面プラズモンの位相速度vzが遅くなることを意味する。

[0025]

なお、図5において、各黒丸印は、伝搬光の波長が488nmの場合に比誘電率の実数部の値がマイナス7.38の銀(Ag)により光導波路13の内面全体を構成した場合(本実施形態の場合)における前記幅狭部16の内面幅寸法axと表面プラズモンの位相速度vzとの関係を示したものである。また、縦軸における一番上の目盛り数値「1」のやや下から水平方向(横軸方向)に延びた一点鎖線は、前記内面幅寸法axの数値が無限大(∞)であるとした場合における前記速度比率(vz/C)の大きさを示したものである。

[0026]

[0027]

そして特に、内面幅寸法 $a \times < \lambda / 5$ (即ち、 $a \times < 97.6 nm$) になると、前記速度比率 ($v \times z / C$) は、一層、加速度的に低下し始める。そして、内面

幅寸法 $a \times < \lambda / 10$ (即ち、 $a \times < 48.8nm$) になると、更に一層、前記速度比率 ($v \times z / c$) は急激に大きく低下している。なお、前記内面幅寸法 $a \times x / c$ が伝搬光の波長 (488nm) の1/2 よりも大きくされた場合は、図 5 に一点鎖線で示す内面幅寸法 $a \times z / c$ に近付いていくことになる。

[0028]

従って、このことから、光導波路13の内表面に発生した表面プラズモンは、本実施形態における幅狭部16のように、光導波路13内において、伝搬光の波長の1/2よりも小さな内面幅寸法ax(<244nm)にした部分では、その位相速度vzが大幅に遅くなることが理解される。そして、表面プラズモンのような光波は、その伝搬において位相速度vzが遅い(小さい)空間に集まる性質がある。そのため、光導波路13の幅狭部16及び幅広部17を含む内表面全域において発生した表面プラズモンは、その位相速度vzが遅く(小さく)なるように伝搬光の波長の1/2よりも小さな内面幅寸法ax(<244nm)に設定された幅狭部16に集まることになる。

[0029]

従って、光源を強くしたりする方法によらずとも、本実施形態の光導波装置11では、前記幅狭部16の部分において、表面プラズモンの電界強度が強くなると共に、その位相速度 v z が遅くなって光導波路13内で発生した表面プラズモンが集まるため、光導波路13を介して伝搬される光の強度が強くなる。そして、このように光強度が増大された伝搬光が、前記微小開口15の幅狭部16の部分からスポット光(近接場光)として滲み出し、当該スポット光が試料表面で散乱され、その散乱光が図示しない外部レンズ等を有する光検出装置に検出される

[0030]

なお、参考までに、金属製板体12の表面部12aに形成される微小開口15 の開口形状に関して、本実施形態の微小開口15とは異なる開口形状をした比較 例(比較例1と比較例2)を示して、各々の微小開口を通過する光の強度を対比 してみた。図6において、(a)は本実施形態における微小開口15を、(b) は比較例1 (本発明の別の実施形態でもある)の微小開口25を、(c)は比較例2の微小開口35を、それぞれ正面から見たものである。同図からも理解されるように、比較例1の微小開口25は、短手方向の内面幅寸法と長手方向の形状寸法が本実施形態の微小開口15における幅狭部16の内面幅寸法ax及び形状寸法Lとそれぞれ同寸法の縦長方形状をしている。また、比較例2の微小開口35は、正方形状をなしており、その一辺の長さが本実施形態の微小開口15における幅広部17の内面幅寸法bxよりも大きいものである。

[0031]

そこで、これら各微小開口15,25,35を同一条件のもと光が通過したとした場合において、各微小開口15,25,35の中心〇を通る仮想平面上での光の強度を調べてみた。図7は、各微小開口25,15,35の中心〇を横方向(図6ではX方向)に通る仮想平面上での光の強度分布を示したものであり、図8は、各微小開口25,15,35の中心〇を縦方向(図6ではY方向)に通る仮想平面上での光の強度分布を示したものである。なお、図7,図8において、曲線aは本実施形態の微小開口15を通過した光の強度分布曲線を、曲線bは比較例1の微小開口25を通過した光の強度分布曲線を、曲線cは比較例2の微小開口35を通過した光の強度分布曲線を、それぞれ示している。

[0032]

さて、図7及び図8を見てみると、本実施形態における微小開口15の場合には、その各分布曲線 a からも明らかなように、当該微小開口15の中心〇の近傍で非常に高い光強度が得られている。これは、前述したように、幅狭部16において対向する両界面Sでの表面プラズモン同士が互いに結合して電界強度を上げていることが、その要因の1つとしてあげられる。そして、要因の二つとしては、前記幅狭部16では表面プラズモンの位相速度が遅く(小さく)されるため、光導波路13内を伝搬される光が前記幅狭部16に集中することにあると考えられる。

[0033]

次に、比較例1の微小開口25の場合について見てみると、当該微小開口25 の場合も、その各分布曲線bから明らかなように、微小開口25の中心〇の部分 を最大値とする光強度分布を示している。これは、この比較例1の微小開口25においても、その短手方向において互いに対向する両界面の表面プラズモンの結合効果が発揮されているものと考えられる。なお、分布曲線 a で表された本実施形態における微小開口15に比較すると、その電界強度の高さは低いが、これは開口形状が縦方向に一様の内面幅寸法とされた長方形状であり、本実施形態の微小開口15のような幅狭部16と幅広部17が連続して繋がった形状ではないことに起因するものと考えられる。

[0034]

従って、この比較例1の微小開口25では、本実施形態の微小開口15に比較して、表面プラズモンの位相速度を遅く(小さく)して伝搬光を集束させるという点では少しばかり劣るものの、両界面で発生した表面プラズモンが結合して電界強度を上げるという点では、共通した効果を示しているといえる。その意味で、この比較例1は、本実施形態と技術思想的には共通したものであり、本発明における別の実施形態(別例)と位置付けられるものである。

[0035]

これに対し、比較例2の微小開口35の場合には、その各分布曲線cからも明らかなように、表面プラズモンが発生する左右両界面の近傍付近でのみ少し程度は光強度が認められるものの、当該微小開口35の中心Oの部分ではほとんど光強度が認められない。即ち、比較例2の微小開口35の場合には、両界面で発生した表面プラズモンの結合による電界強度向上効果もなく、また、それ故に、表面プラズモンの位相速度を遅く(小さく)して伝搬光を集束させるという効果もなく、これでは実用面での支障となる。

[0036]

従って、本実施形態の光導波装置11によれば、次のような効果がある。

(1) 本実施形態では、光導波路13を貫通形成した金属製板体12がプラズモン活性媒質である銀(Ag)により構成されているため、光導波路13に光が入射されたことに基づき、その光導波路13(微小開口15を含む)の内表面で表面プラズモンが発生する。また、その光導波路13(微小開口15)は、幅狭部16の内面幅寸法axが光の波長の1/2よりも小さな31nmに設定されて

いるため、その幅狭部16の対向する両界面Sで発生した表面プラズモンは、互いに電界が結合することで電界強度が非常に強くなる。しかも、その幅狭部16の部分では表面プラズモンの位相速度が遅くなるため、光導波路13内の光が当該幅狭部16に集まることになる。従って、このような幅狭部16を有したことにより、光導波路13の先端側開口である微小開口15から滲み出すスポット光(近接場光)の光強度を、光源を強くせずとも、光の広がりの増大を招くことなく、低コストで増強することができる。

[0037]

(2)また、本実施形態では、光導波路13(微小開口15)の幅狭部16と幅広部17とが連続する方向における光導波路13(微小開口15)の形状寸法 Lが所定の形状寸法計算値よりも大きく設定されている。即ち、幅狭部16で発生する表面プラズモンの位相速度vzを伝搬光の真空中の速度である光速Cで除した値に前記伝搬光の波長の1/2を乗じて得られる値(形状寸法計算値)よりも大きな値に設定されている。従って、その光導波路13内へ光ファイバFから入射された光を遮断してしまうようなこともなく、確実に先端の微小開口15から光の強度を増強したスポット光(近接場光など)として導出することができる

[0038]

(3)また、本実施形態では、微小開口15に連なる開口近傍の内面部分のみならず光導波路13の内面全体がプラズモン活性媒質である銀(Ag)により構成されているため、光導波路13の内表面全域で表面プラズモンを発生させることができる。しかも、幅狭部16が、先端側の微小開口15から裏面側開口14まで連続形成されているため、互いに対向する両界面Sの表面プラズモンが結合することによる電界強度向上効果及び伝搬される光の位相速度を遅くして当該光を幅狭部16に集中させる効果を、光導波路13の内面全体に亘り得ることができる。

[0039]

(4)また、本実施形態では、プラズモン活性媒質として負誘電体媒質である 銀(Ag)を採用しているので、表面プラズモンを効果的に目つ確実に発生させ ることができる。また、かかるプラズモン活性媒質(Ag等)からなる装置本体 としての金属製板体12に前記光導波路13を形成するだけなので、光導波装置 11の製造が容易にできる。

[0040]

(5)また、本実施形態では、光導波路13の先端に設けられる微小開口15 が伝搬光の波長の1/2よりも小さな値の内面幅寸法axとされた幅狭部16を有するものであって、その幅狭部16に連なる光導波路13の内面部分をプラズモン活性媒質で構成するだけという簡単なものである。そのため、走査近接場光学顕微鏡や光情報記録装置等という様々な光学的処理装置における光導波装置として好適に使用することができる。

[0041]

なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。

・ 上記実施形態では、微小開口15において幅狭部16が1つだけ設けられたものであったが、例えば図9(a)に示すように、2つの幅狭部16と3つの幅広部17を有し、それらの幅狭部16と幅広部17が交互に連続する開口形状としてもよい。このようにすれば、光の強度を増強したスポット光(近接場光など)を2カ所で形成することができる。要するに、幅狭部16は微小開口15において少なくとも一カ所あればよく、幅広部17と隣り合って連続するものならば二カ所以上あってもよい。

[0042]

・ 上記実施形態では、微小開口15の開口形状が幅狭部16及び幅広部17 を含めて直線により形作る構成となっていたが、例えば図9(b)に示すように 曲線を用いて形作られた開口形状(例えば、同図に示すようなダンベル形状)で あってもよい。また、微小開口15の開口形状は直線と曲線の組み合わせで形成 されていてもよい。

[0043]

・ 上記実施形態では、微小開口15の開口形状が左右対称な形状になっていたが、幅狭部16と幅広部17が交互に連続するものならば、開口形状は任意に変更可能である。例えば、図9(c)(d)に示すように、幅狭部16と幅広部

17が伝搬光の偏光方向(各図において幅狭部16の幅方向)と交差する方向へ 連続して繋がった形状となるならば、左右非対称な形状であってもよい。

[0044]

・ 上記実施形態では、光導波路13の全体に亘り光伝搬方向に直交する断面の形状が微小開口15の開口形状と同一となるように形成されていたが、例えば図10(a)(b)に示すように、金属製板体12内で光導波路13の断面形状が微小開口15の開口形状よりも大きくなっていてもよい。また、裏面側開口14から入射される光の偏光方向を同図のY方向(縦方向)とする場合には、幅狭部16と幅広部17がX方向(横方向)に連続して繋がるようにすればよい。

[0045]

・ 上記実施形態では、幅狭部16が光導波路13の光伝搬方向に交差する断面の形状中心に位置するように形成されていたが、例えば図11(a)(b)に示すように、光導波路13の断面中心から偏心した位置に幅狭部16が設けられるようにしてもよい。また、光導波路13は、幅狭部16の内面幅寸法が伝搬光の波長の1/2よりも小さく設定されるものならば、同図からも窺えるように、幅狭部16の内面幅寸法と幅広部17の内面幅寸法との寸法比が、本実施形態における両者の寸法比に対してはるかに大きなものであってもよい。即ち、幅広部17の内面幅寸法は幅狭部16の内面幅寸法よりも大きいという条件を満たすならば無限大の寸法であってもよい。

[0046]

・ 上記実施形態では、光導波路13が装置本体たる金属製板体12に対してトンネル状に貫通形成されたものであったが、例えば図12(a)(b)および図13(a)(b)に示すように、金属製板体12の表面上から溝状に切欠形成されたものであってもよい。ちなみに、図12(a)(b)のものは、金属製板体12の上面から幅狭部16が切欠形成され、当該幅狭部16の下方に連続するように幅広部17が繋がり形成されたものである。また、図13(a)(b)のものは、金属製板体12の上面に幅狭部16が切欠形成されたものであり、原理的には図6(b)に示した比較例1と同様のものである。従って、本発明でいうところの光導波路の端部開口には、金属製板体12に貫通形成された光導波路1

3の端部開口(図1等の微小開口15)である場合と、金属製板体12の一側面に溝状に切欠形成された光導波路13の端部開口(図12,図13の微小開口15)である場合の双方が含まれるものである。

[0047]

・ 上記実施形態では、光導波路13の両端部にそれぞれ開口(裏面側開口14及び微小開口15)を設けたが、光導波路13は、先端側開口の微小開口15が一つだけ設けられた構成でもよい。即ち、例えば図10(a)(b)の光導波装置11において裏面側開口14が閉塞された構成であってもよい。このように構成した場合には、先端の微小開口15から光導波路13内に入射された伝搬光が当該光導波路13内奥の壁面で反射されて定在波を発生させ、再び、先端の微小開口15から導出されることになり、イルミネーションコレクションモードの場合に好適に利用される。

[0048]

・ 上記実施形態では、光導波路13内において表面プラズモンの結合による 電界強度向上効果および表面プラズモンの位相速度低下による伝搬光集中効果を 発揮し得る幅狭部16(及びその内面部分18)が一直線状に設けられていた。 しかし、例えば図10(a)(b)及び図11(b)に一点鎖線で示すように、 光導波路13内において、前記幅狭部16(及びその内面部分18)は二股状に 分岐した構成であってもよい。なお、その場合、分岐された幅狭部16の先端に 対応させて微小開口15と同様の先端側開口を形成してもよい。また、その場合 の分岐形態は、二股状のみならず一カ所から三方向へ分岐させてもよいし、複数 箇所でそれぞれ複数方向へ分岐させてもよい。

[0049]

このようにすれば、例えば光集積回路における光導波路13として用いた場合に極めて実用的なものになる。即ち、光集積回路では、ナノメータ単位の極細い光の配線回路を作るため、光導波路を二次元面内で引き回す(曲げたり、分岐したりする)必要がある。そして、そのようにして形成された回路のうち、光導波路を電界と平行な二次元面内で引き回して形成された回路はE面回路と呼ばれ、光導波路を磁界と平行な二次元面内で引き回して形成された回路はH面回路と呼

ばれる。

[0050]

上記した図10(a)(b)において幅狭部16(及びその内面部分18)が 分岐した光導波路13は、その電界が主にY方向であり磁界が主にX方向である ところ、X方向の磁界と平行な二次元面内で分岐されているためH面回路を形成 していることになる。一方、図11(a)(b)において幅狭部16(及びその 内面部分18)が分岐した光導波路13は、その電界が主にX方向であり磁界が 主にY方向であるところ、X方向の電界と平行な二次元面内で分岐されているた めE面回路を形成していることになる。

[0051]

従って、H面回路を形成する図10(a)(b)の光導波装置11においては、同図におけるY方向で対向する幅狭部16の内面幅寸法が伝搬光の波長の1/2よりも小さな値であれば、幅広部17のY方向における内面幅寸法が例え無限大であっても、分岐された各幅狭部16に沿う極細の光回路を形成できる。また、E面回路を形成する図11(a)(b)の光導波装置11においては、同図におけるX方向で対向する幅狭部16の内面幅寸法が伝搬光の波長の1/2よりも小さな値であれば、幅広部17のX方向における内面幅寸法が例え無限大であっても、分岐された各幅狭部16に沿う極細の光回路を形成できる。

[0052]

・ また、図12(a)(b)に示す形態のものにあっては、例えば図14~図16に示すような形態に変更してもよい。即ち、図14のものは幅狭部16が一つではなく複数(同図では2つ)形成され、各幅狭部16の下部が一つの幅広部17に連続して繋がるように構成されたものである。また、図15のものは、図14のものにおいて、光導波路13内に外部(空気)とは異なる誘電体媒質(ガラス等)を充填したものである。また、図16のものは光導波路13の断面形状が不規則な曲線で形成されたものであり、その光導波路13内には図14のもののようにガラス等の誘電体媒質が充填されていてもよい。

[0053]

・ 上記実施形態では、プラズモン活性媒質として比誘電率の実数部の値がマ

イナス7.38の銀(Ag)を用いたが、実数部の値がマイナスの銀(Ag)であれば他の銀(Ag)を用いてもよい。また、比誘電率の実数部の値がマイナスとなる誘電体媒質であれば、銀(Ag)に限らず金(Au)や白金及びそれらの合金、又はその他の金属材料や半導体材料を用いてもよい。

[0054]

・ 上記実施形態では、光導波路13を包囲形成する金属製板体12全体をプラズモン活性媒質(銀Ag)により構成していたが、少なくとも光導波路13内の幅狭部16において幅方向で対向する内面部分18がプラズモン活性媒質(銀Ag)により構成されていればよい。また、先端側開口の微小開口15から裏面側開口14に至るまでの光導波路13の内面全体に亘り形成された幅狭部16の幅方向で互いに対向する両内面部位のみがプラズモン活性媒質(銀Ag)により構成されていてもよい。また、前記プラズモン活性媒質(銀Ag等)は、前記幅狭部16の内面部分18等を含む光導波路13の内表面に対して蒸着などで付設されるものであってもよい。

[0055]

・ 上記実施形態では、微小開口15における幅狭部16の内面幅寸法axが31nmに設定されていたが、伝搬光の波長の1/2よりも小さな寸法に設定されるものならば、上記実施形態の31nmに限定されるものではない。また、微小開口15における幅方向(X方向)と交差する方向(Y方向)の形状寸法Lは217nmに限定されるものではなく、前記形状寸法計算値よりも大きな値に設定されるならば、前記形状寸法Lは伝搬光の波長の1/2より大きくてもよい。

[0056]

・ 上記実施形態では、光導波路13の光伝搬方向と直交する断面形状が微小 開口15と同一形状で裏面側開口14まで連続する構成であったが、例えば裏面 側開口14側から先端の微小開口15に向かうほど次第に断面形状が小さくなる 先細テーパ状にするなど、光導波路13の全体形状は適宜に変更可能である。

[0057]

・ 上記実施形態では、光導波路13内において当該光導波路13の内表面と 界面Sを形成する媒質が空気であったが、例えば図14のものにおいて示唆した ようにガラスなどの他の誘電体媒質を光導波路13内に充填したものであっても よい。

[0058]

・ 上記実施形態では、光導波路13の内面全体に亘り幅狭部16が形成されていたが、光導波路13の先端側開口である微小開口15においてのみ幅狭部16が形成された構成であってもよい。また、光導波路13の光伝搬方向における中途に断面形状が前記微小開口15と同様の幅狭部16と幅広部17が連続して繋がった形状をなす部分を設け、先端側開口及び裏面側(基端側)開口は、それぞれ伝搬光の波長よりも大きな開口となるようにしてもよい。

[0059]

次に、前記実施形態から把握される技術的思想について以下追記する。

(イ)前記光導波路は、その幅狭部の内面幅寸法が伝搬光の波長の2/5より も小さな値に設定されている請求項1~請求項7のうち何れか一項に記載の光導 波装置。

[0060]

(ロ)前記光導波路は、その幅狭部の内面幅寸法が伝搬光の波長の3/10よりも小さな値に設定されている請求項1~請求項7及び上記技術的思想(イ)のうち何れか一項に記載の光導波装置。

[0061]

(ハ) 前記光導波路は、その幅狭部の内面幅寸法が伝搬光の波長の1/5より も小さな値に設定されている請求項1~請求項7及び上記技術的思想(イ)(ロ)のうち何れか一項に記載の光導波装置。

[0062]

(二)前記光導波路は、その幅狭部の内面幅寸法が伝搬光の波長の1/10よりも小さな値に設定されている請求項1~請求項7及び上記技術的思想(イ)~(ハ)のうち何れか一項に記載の光導波装置。

[0063]

【発明の効果】

以上、詳述したように、本発明によれば、光導波路を介して伝搬される光の光

強度を、その光の広がりの増大を招くことなく、低コストで増強することができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本実施形態の光導波装置に光ファイバを接続した状態の斜視図。
- 【図2】 同じく、光導波装置の正面図。
- 【図3】 (a)は図2のA-A線断面図、(b)は図2のB-B線断面図
- 【図4】 図2のC-C線断面図。
- 【図5】 幅狭部の幅寸法と表面プラズモンの位相速度との対応関係図。
- 【図6】 (a)は本実施形態の正面図、(b)は比較例1の正面図、(c)は比較例2の正面図。
- 【図7】図6(a)~(c)の各微小開口を通過した光のX軸方向仮想平面上での光強度分布図。
- 【図8】図6(a)~(c)の各微小開口を通過した光のY軸方向仮想平面上での光強度分布図。
 - 【図9】(a)~(d)は、微小開口の開口形状が異なる各別例の正面図。
- 【図10】本発明の別の実施形態を示すもので、(a)は正面図、(b)は同図(a)のA-A線断面図。
- 【図11】本発明の別の実施形態を示すもので、(a)は正面図、(b)は同図(a)のA-A線断面図。
- 【図12】本発明の別の実施形態を示すもので、(a)は正面図、(b)はその平面図。
- 【図13】本発明の別の実施形態を示すもので、(a)は正面図、(b)はその平面図。
 - 【図14】光導波路の光伝搬方向に交差する断面形状が異なる別例の断面図
 - 【図15】光導波路の光伝搬方向に交差する断面形状が異なる別例の断面図
 - 【図16】光導波路の光伝搬方向に交差する断面形状が異なる別例の断面図

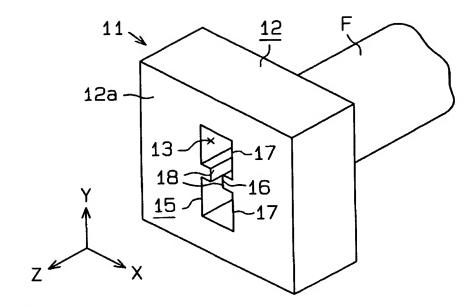
特2002-217084

【符号の説明】

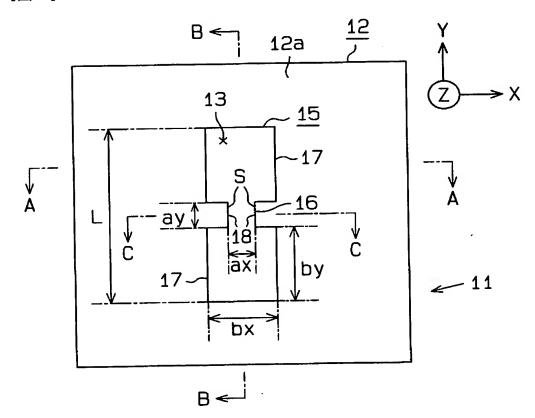
11…光導波装置、13…光導波路、15…微小開口、16…幅狭部、17…幅広部、18…幅狭部において幅方向で対向する内面部分、ax…幅狭部の幅寸法、bx…幅広部の幅寸法、L…光導波路の形状寸法。

【書類名】 図面

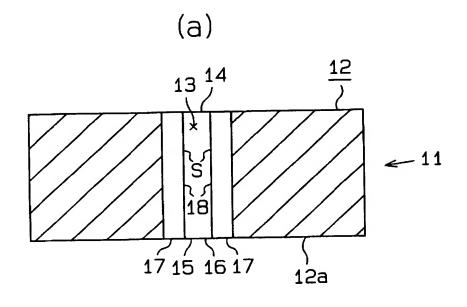
【図1】

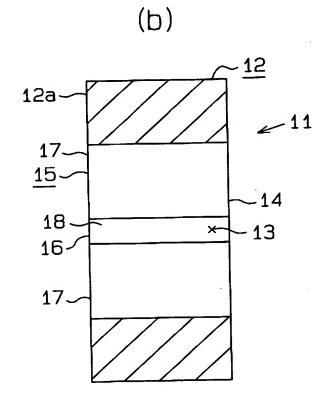


【図2】

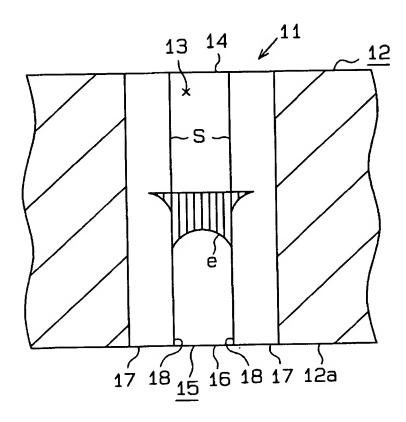


【図3】

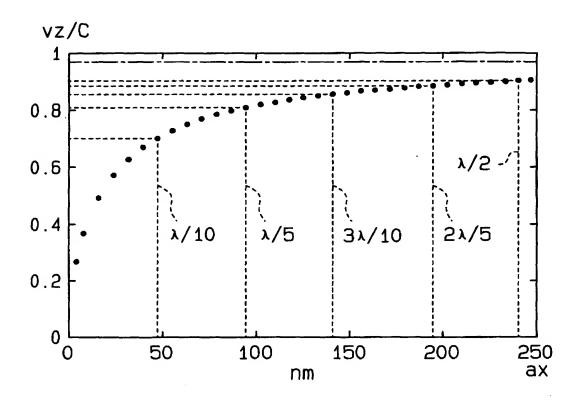




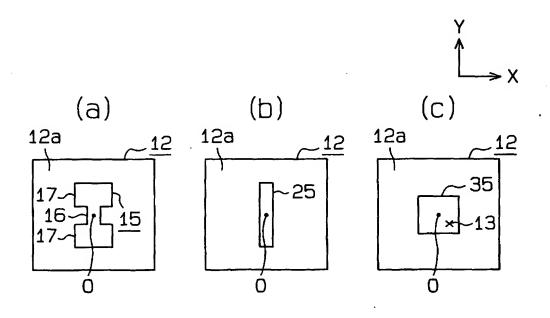
【図4】



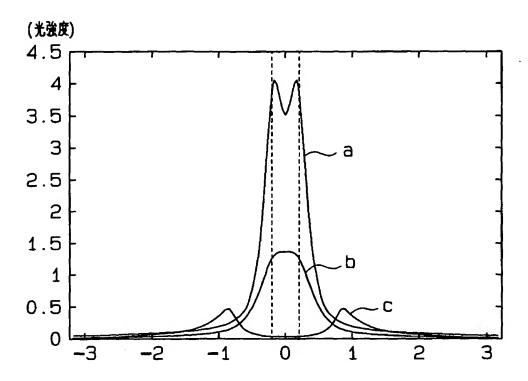




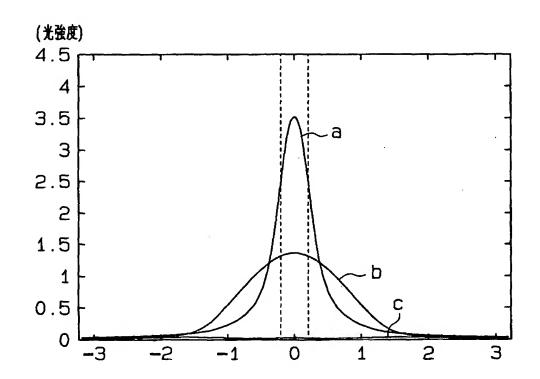
【図6】



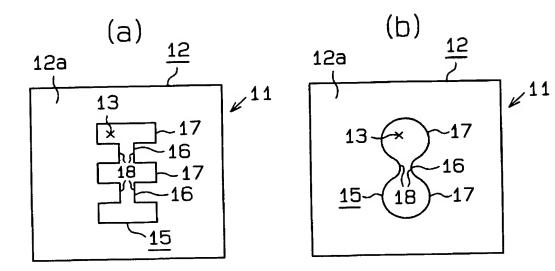
【図7】

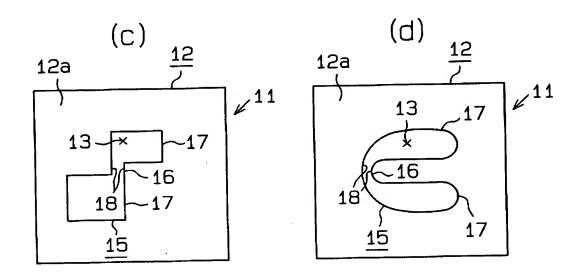


【図8】

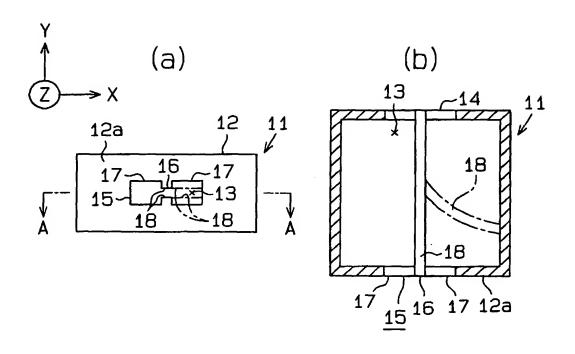


【図9】

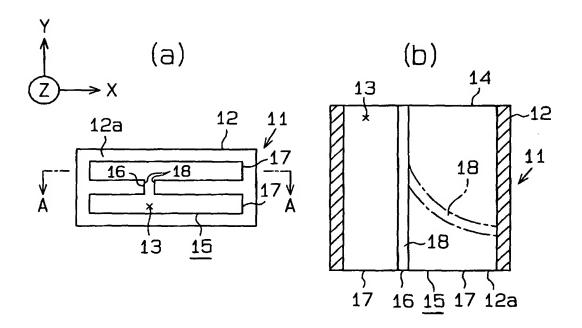




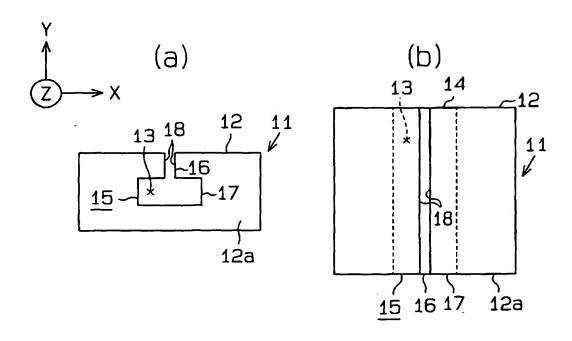
【図10】



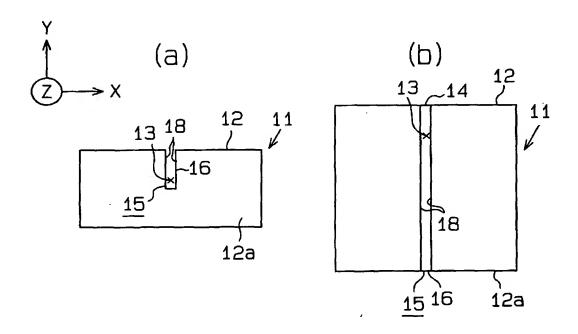
【図11】



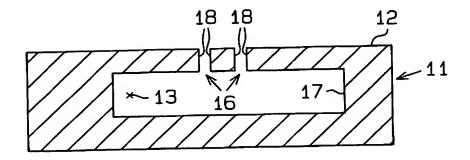
【図12】



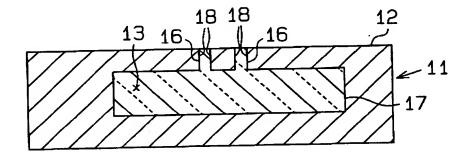
【図13】



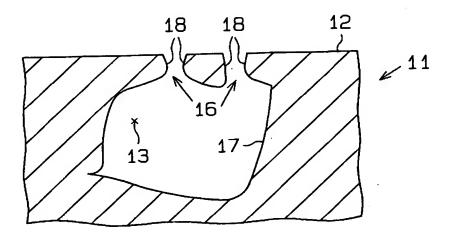
【図14】



【図15】



【図16】



特2002-217084

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】光導波路を介して伝搬される光の光強度を、その光の広がりの増大を招くことなく、低コストで増強することができる光導波装置を提供する。

【解決手段】光導波装置11は、比誘電率の実数部が負の値となる負誘電体媒質からなる金属製板体12の厚さ方向へ光導波路13が貫通形成されている。光導波路13の先端側開口は、伝搬される光の偏光方向を幅方向とした場合に、当該幅方向の内面幅寸法が伝搬光の波長の1/2よりも小さな値の幅狭部16と当該幅狭部16よりも内面幅寸法が大きい幅広部17とが前記幅方向と交差する方向へ連続して繋がった形状の微小開口15とされている。従って、光導波路13内を光が伝搬される際には、前記幅狭部16の幅方向で対向する両内面部分18で発生した表面プラズモンが結合し、電界強度を上げると共に、その位相速度を遅くし、その結果、幅狭部16に前記伝搬光を集束する。

【選択図】 図1

出願 人履歴 情報

識別番号

[391012257]

1. 変更年月日

1991年 1月22日

[変更理由]

新規登録

住所

岐阜県岐阜市柳戸1番1

氏 名

岐阜大学長